

[Диод 2А517Б-2](#)

[Перейти на сайт для заказа](#)



Описание и технические параметры

Диод 2А517Б-2 кремниевый, эпитаксиальный, переключаемый. Рабочим элементом диода является полупроводниковая структура типа n-i-p. Предназначен для применения в переключающих устройствах, модуляторах, аттенюаторах сантиметрового диапазонов длин волн в составе гибридных интегральных микросхем, обеспечивающих герметизацию и защиту приборов от воздействия влаги, соляного тумана, плесневых грибов, инея и росы, пониженного и повышенного давления. Выпускается в бескорпусном исполнении с гибкими выводами. Тип диода приводится на этикетке. Положительный электрод имеет гибкий вывод. Масса диода не более 0,0016 г.

Технические характеристики диода кремниевого эпитаксиального переключаемого 2А517Б-2:

Критическая частота переключения диода, ГГц - 75
Непрерывная рассеиваемая мощность, Вт - 0,5
Постоянный прямой ток, мА - 100
Постоянное обратное напряжение, В - 150
Пробивное напряжение, В - 300
Накопленный заряд диода, нКл - 5
Прямое сопротивление потерь, Ом - 5
Общая емкость диода, пФ - 0,3
Температура окружающей среды, °С - от -60 до +125
Минимальная наработка, ч - 5000
Срок сохраняемости, лет - 25